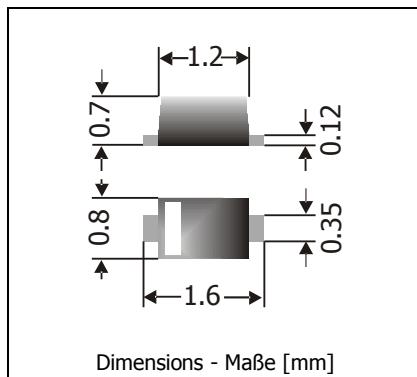


BAS216WT
Fast Switching Surface Mount Si-Planar Diodes
Schnelle Si-Planar-Dioden für die Oberflächenmontage

Version 2010-11-30



Power dissipation – Verlustleistung	150 mW
Repetitive peak reverse voltage	85 V
Periodische Spitzensperrspannung	
Plastic case – Kunststoffgehäuse	SOD-523
Weight approx. – Gewicht ca.	0.01 g
Plastic material has UL classification 94V-0	
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled	
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	

**Maximum ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$)****Grenzwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**

BAS216WT		
Power dissipation – Verlustleistung	P_{tot}	150 mW ¹⁾
Max. average forward current – Dauergrenzstrom (dc)	I_{FAV}	150 mA ¹⁾
Non repetitive peak forward surge current Stoßstrom-Grenzwert	$t_p \leq 1 \text{ s}$ $t_p \leq 1 \mu\text{s}$	I_{FSM} I_{FSM}
Repetitive peak reverse voltage – Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	85 V
Junction temperature – Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_j T_s	-55...+150°C -55...+150°C

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**

Forward voltage ²⁾ Durchlass-Spannung ²⁾	$I_F = 1 \text{ mA}$ $I_F = 10 \text{ mA}$ $I_F = 50 \text{ mA}$ $I_F = 150 \text{ mA}$	V_F V_F V_F V_F	< 715 mV < 855 mV < 1.0 V < 1.25 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = 75 \text{ V}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$ $V_R = 25 \text{ V}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$ $V_R = 75 \text{ V}$	I_R I_R I_R	< 1 μA < 30 μA < 50 μA
Max. junction capacitance – Max. Sperrsichtkapazität $V_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$		C_T	1.5 pF
Reverse recovery time – Sperrverzug $I_F = 10 \text{ mA}$ über/through $I_R = 10 \text{ mA}$ bis/to $I_R = 1 \text{ mA}$		t_{rr}	< 4 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft		R_{thA}	< 620 K/W ¹⁾

1 Mounted on P.C. board with 3 mm^2 copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm^2 Kupferbelag (Löt pad) an jedem Anschluss

2 Tested with pulses $t_p = 300 \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300 \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

